

Wafer Edge Analysis

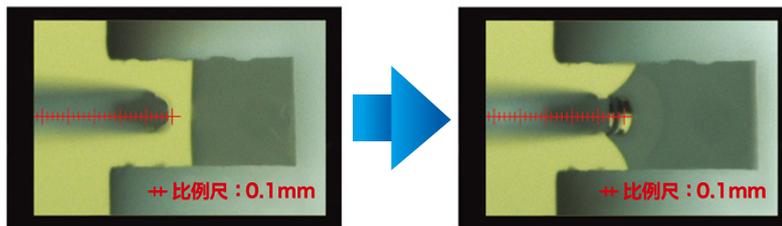
晶圓 (Wafer) 邊緣與斜角部位的汙染評價

高精度區域採樣分析

Wafer 邊緣區域的評價

獨家技術研發之高精度接液控制方法，可分別對邊緣區域與斜角區域進行評價。
此外，Wafer上薄膜（氧化膜、金屬膜等）的邊緣區域也可進行評價。

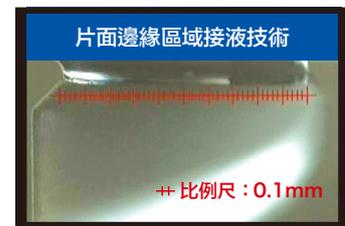
< 邊緣、斜面區域接液案例 >



接液前

接液後 0.3mm

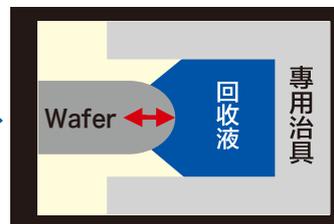
< 片面邊緣區域接液案例 >



接液 5mm



(示意圖)



(示意圖)

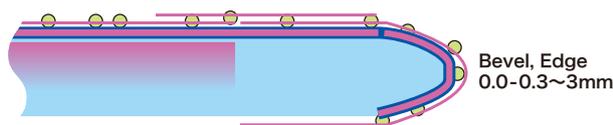


(示意圖)

邊緣、斜角部的分析領域

Wafer 邊緣、斜角區域的最表面與表層，皆可進行局部採樣。

Depth : 0-20 nm ~ 10 μ m
Edge (片面) : 0.5-5 ~ 10 mm



● Particle ■ Thin Film ■ Bulk

斜角區域的定量下限

- 4~9E+ 9 atoms/cm²
- 1~2E+10 atoms/cm²
- 2~4E+10 atoms/cm²
- 1~4E+11 atoms/cm²
- 4 E+11 molecules/cm² ~ (離子成分)

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	L	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	A															

※ 300mm Wafer, 厚度 0.7mm